

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

本発明は、多量の含硫黄分子の固定化を可能にする金メッキ体、金メッキ体の表面処理方法及び表面処理物並びに含硫黄分子の固定化法を提供することを課題とする。

本発明の表面処理方法は、多数の含硫黄分子が固定化可能なように、金メッキ体の表面に、温度350～790℃でアニール化処理を施すものである。特に、表面金結晶が(1, 1, 1)面の配向面を30%以上有する構造になるように処理するものである。さらに、本発明は、表面に多数の含硫黄分子が固定化可能な金メッキ体を製造する方法で、結晶成長剤を含む原料から表面金結晶を形成する金メッキ体の製造方法を提供するものである。